

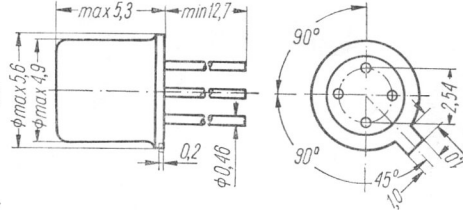
# 3SK21H

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: HITACHI

Wykonanie: tranzystor polowy MOS, kanał typu N, w obudowie metalowej TO-72

Zastosowanie: przerywacze



Rys. 1-1283. 3SK21H

## Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

	min	typ	max		
$U_{(BR)DSX}$	20			V	przy $I_D = 10 \mu A$ , $U_{G1S} = -6 V$
$I_{G1SS}$			1,0	pA	przy $U_{G1S} = -6 V$ , $U_{DS} = 0$
$U_{G1SC}$			-6,0	V	przy $I_D = 10 \mu A$ , $U_{DS} = 6 V$
$I_{DSS}$	3		16	mA	przy $U_{DS} = 6 V$ , $U_{G1S} = 0$
$y_{21s}$	2,5			mS	przy $U_{DS} = 6 V$ , $I_D = I_{DSS}$ , $f = 1 kHz$
$C_{11s}$		5,0		pF	przy $U_{DS} = 6 V$ , $I_D = I_{DSS}$ , $f = 1 MHz$
$R_{ON}$		250	300	$\Omega$	przy $U_{DS} = 0,1 V$ , $U_{G1S} = 0$
$R_{OFF}$	100			M $\Omega$	przy $U_{DS} = 0,1 V$ , $U_{G1S} = -6 V$

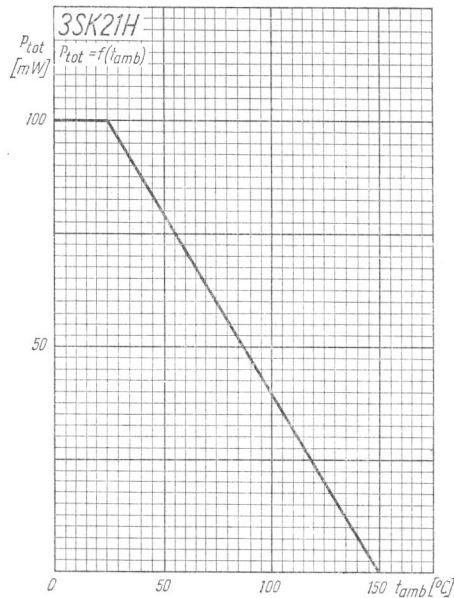
## Wartości graniczne

$U_{DSX max}$	20 <sup>2)</sup>	V	$P_{tot max}$	100	mW
$U_{G1SX max}$	+5 <sup>3)</sup>	V	$i_j max$	150	$^{\circ}C$
$U_{G1SO max}$	$\pm 20$	V	$i_{stg}$	-55 ÷ +150	$^{\circ}C$
$I_D max$	10	mA			

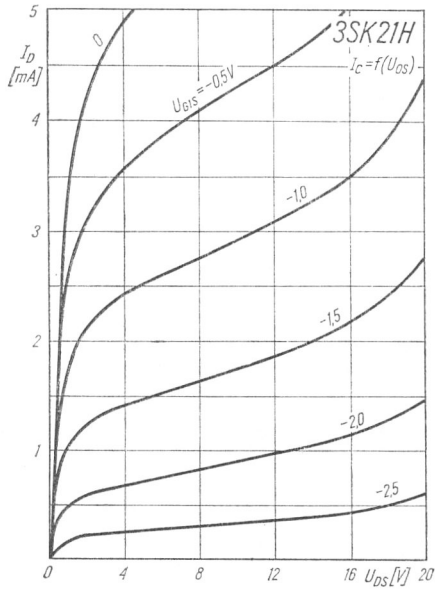
<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 25^{\circ}C$

<sup>2)</sup>  $U_{G1S} = -6 V$

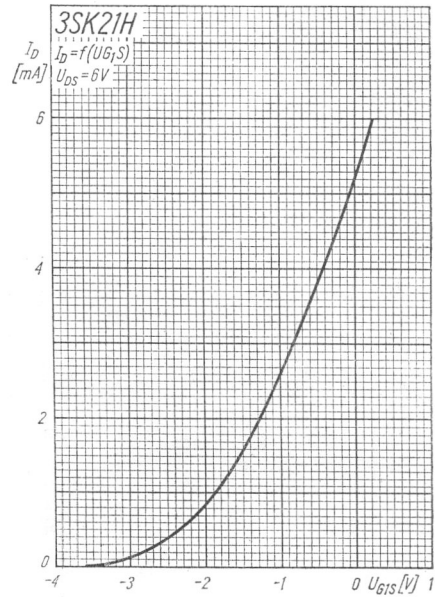
<sup>3)</sup>  $U_{DS} = 1 V$



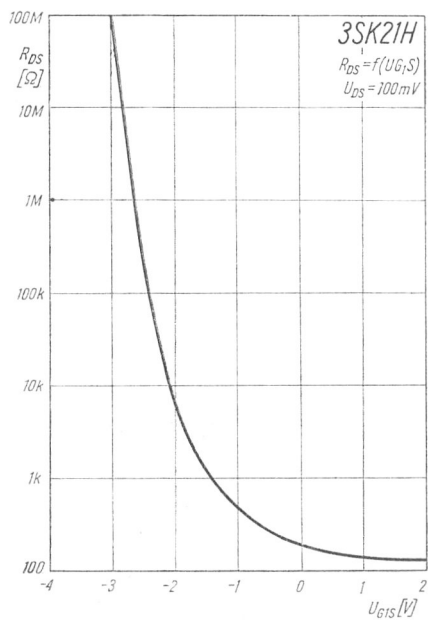
Rys. 1-1284. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



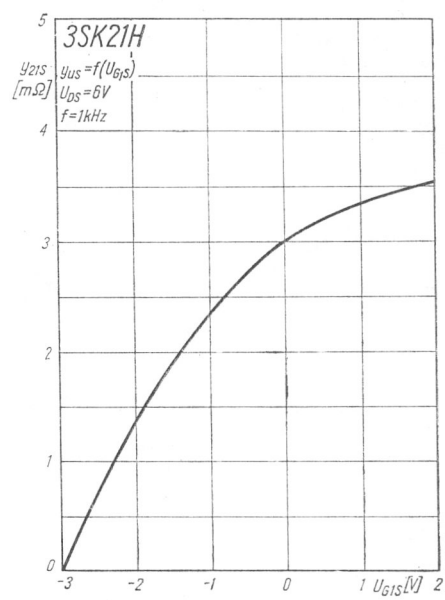
Rys. 1-1285. Charakterystyki statyczne tranzystora



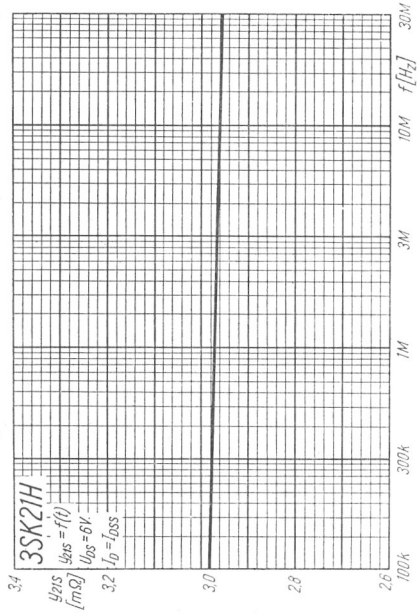
Rys. 1-1286. Zależność prądu drenu od napięcia bramki  $U_{G1S}$



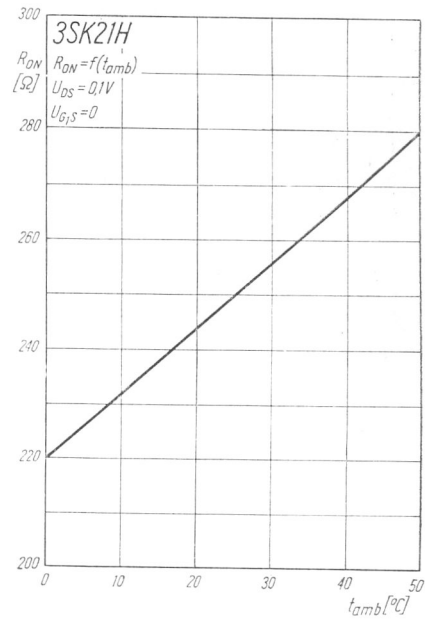
Rys. 1-1287. Zależność rezystancji dren-źródło od napięcia bramki  $U_{G1S}$



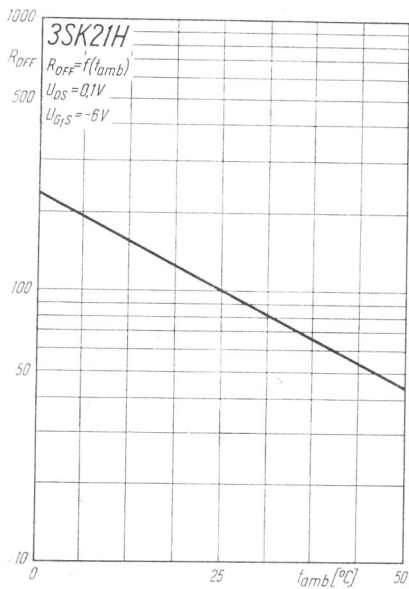
Rys. 1-1288. Zależność admittancji  $y_{21e}$  od napięcia bramki  $U_{G1S}$



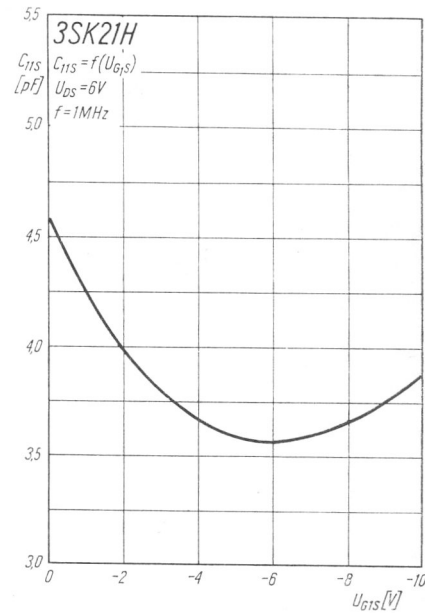
Rys. 1-1289. Zależność admittancji  $Y_{21s}$  od częstotliwości



Rys. 1-1290. Zależność rezystancji włączania od temperatury otoczenia



Rys. 1-1291. Zależność rezystancji wyłączenia od temperatury otoczenia



Rys. 1-1292. Zależność pojemności wejściowej od napięcia bramki  $U_{G1S}$